

第3回 シリコンフォトニクス技術フォーラム

平成22年3月10日(水)13:00~17:00

リーガロイヤル東京(東京都新宿区)

“光・電子融合技術の最前線”

主催 財団法人光産業技術振興協会
—シリコンフォトニクス・ブレークスルー技術委員会—
協賛 技術研究組合 光電子融合基盤技術研究所

シリコンフォトニクス技術は、光・電子融合技術の最前線にあり、半導体LSIの一層の性能向上の突破口として期待され注目を集めています。本フォーラムは、三年目を迎え、第一回目を技術シーズの視点、第二回目をニーズの視点から検討し、産学官連携の立場からシリコンフォトニクス技術の現状と将来展望の議論を重ねて参りました。今回も、本分野に関連する第一人者をお招きして総合的観点から最前線の動向を捉えなおし、今後の進むべき方向を探ります。参加された方々には、この機会をシリコンフォトニクス技術を駆使した新しい技術開発や新製品のイメージをつくるための討論の場として十分にご活用いただきますようお願いいたします。

開催日時: 平成22年3月10日(水)13:00~17:00

開催場所: リーガロイヤルホテル東京 2階 ダイアモンド (地下鉄東西線早稲田駅より徒歩約7分)

〒169-8613 東京都新宿区戸塚町1-104-19 TEL: 03-5285-1121 <http://www.rihga-tokyo.co.jp/index.htm>

講演プログラム

13:00-13:05	開会挨拶	小谷 泰久 (光協会)
	座長 和田 一実 (東京大学)	
13:05-13:55	「日本の半導体戦略 -イノベーションを越えて-」	湯之上 隆 (株)イーサービス
13:55-14:45	「シリコンLSIの課題と要求されるイノベーション」	桜井 貴康 (東京大学)
14:45-15:15	Coffee Break	
	座長 井戸 立身 (株)日立製作所	
15:15-16:05	「半導体MIRAIプロジェクト: LSIオンチップ光配線」	大橋 啓之 (日本電気株)
16:05-16:55	「シリコン/III-V族ハイブリッド光デバイスの進展」	荒井 滋久 (東京工業大学)
16:55-17:00	Closing Remarks	荒川 泰彦 (東京大学)

なお、今年度発足した光電子融合基盤技術研究所(PETRA)の設立記念会を開催します。関係各位の積極参加を募ります。
17:00-19:00 光電子融合基盤技術研究所設立記念会 (リーガロイヤルホテル東京 2階 サファイア)

参加費: 講演会・設立記念会いずれも**無料**

申込み方法: 右記サイトよりお申込み下さい。定員(150名) http://www.oitda.or.jp/main/data/silicon_postmail.html

問合せ先: 財団法人光産業技術振興協会 立野、鈴木

〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10 住友江戸川橋駅前ビル7階

TEL: 03-5225-6431 FAX: 03-5225-6435

OITDA

KEIRIN 00 この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
<http://ringring-keirin.jp>